

文档编号: AN2055

上海东软载波微电子有限公司

应用笔记

ES32F362x

修订历史

版本	修订日期	修改概要
V1.0	2024-09-13	初版
V1.1	2025-06-03	1.修改 ADC 注意事项 1、注意事项 2 2.修改温感注意事项 1、增加温感注意事项 2 3.增加 IAP 注意事项 1 4.修改 SPI 的注意事项 4 和 6 5.修改 SPI 的注意事项 3 6.增加 SPI 注意事项 8 和注意事项 9 7.修订 SPI 注意事项 4，增加表 3-3 8. FLASH 增加注意事项 4

地 址：上海市徐汇区古美路 1515 号凤凰园 12 号楼 3 楼

邮 编：200235

E-mail: support@essemi.com

电 话：+86-21-60910333

传 真：+86-21-60914991

网 址：http://www.essemi.com/

版权所有©

上海东软载波微电子有限公司

本资料内容为上海东软载波微电子有限公司在现有数据资料基础上慎重且力求准确无误编制而成，本资料中所记载的实例以正确的使用方法和标准操作为前提，使用方在应用该等实例时请充分考虑外部诸条件，上海东软载波微电子有限公司不担保或确认该等实例在使用方的适用性、适当性或完整性，上海东软载波微电子有限公司亦不对使用方因使用本资料所有内容而可能或已经带来的风险或后果承担任何法律责任。基于使本资料的内容更加完善等原因，上海东软载波微电子有限公司保留未经预告的修改权。使用方如需获得最新的产品信息，请随时用上述联系方式与上海东软载波微电子有限公司联系

目 录

内容目录

第 1 章	概述	4
1.1	开发环境	4
1.2	库函数选择	4
1.3	寄存器写保护	4
1.3.1	系统写保护	4
1.3.2	RTC 写保护	4
1.3.3	IWDG 写保护	4
1.3.4	WWDG 写保护	4
1.4	写 1 清零寄存器	5
1.5	位带操作	5
第 2 章	系统控制	6
2.1	系统时钟	6
2.1.1	内部高速 4MHz(默认时钟)	6
2.1.2	外部时钟 HOSC(4~16MHz)	6
2.1.3	72MHz	6
2.1.4	外部低速时钟(LOSC)	6
2.2	外部晶振	7
2.3	IAP 操作程序	7
2.4	FLASH 模块	7
2.5	配置字	8
第 3 章	外设	9
3.1	GPIO 模块	9
3.2	CAN 模块	9
3.3	IIC 模块	9
3.4	UART 模块	9
3.5	TIMER 模块	9
3.6	SPI 模块	9
3.7	ADC 模块	10
3.8	内部温感	12
第 4 章	最小系统电路	13
4.1	ES32F362x LQFP64 封装芯片最小系统电路	13
4.2	ES32F362x LQFP48 封装芯片最小系统电路	14

第1章 概述

1.1 开发环境

推荐用户使用 Keil5、IAR8.11 或者 GCC 进行固件开发。由于 Keil4 不支持 PACK 机制，故不推荐用户使用 Keil4。使用 ESLINK 或 Jlink 第一次烧录，需进行全擦操作。

1.2 库函数选择

ES32 系列芯片提供 2 种类型库函数 ALD 和 MD：

ALD：提供较为完善的封装，提供更为人性化的 API，适合大部分用户；

MD：基本上只提供寄存器位域级别的“读”、“写”接口，适合对芯片底层较为熟悉的用户。

如果用户对速度不是要求非常严格，一般情况下推荐用户使用 ALD 库。可以减少用户学习时间，增加代码可移植性，最终缩短用户产品的开发周期。

1.3 寄存器写保护

为避免程序的异常导致运行错误，芯片写保护寄存器用于阻止对被保护的寄存器误操作。

系统控制单元，GPIO，RTC，WDT 等模块支持寄存器写保护，对被保护的寄存器进行写之前需要解除写保护状态（允许写），否则无法对写保护寄存器写入。操作完成后，再使能写保护（禁止写）。库函数中均提供相应宏定义进行解除保护和使能保护。

1.3.1 系统写保护

系统控制寄存器的访问操作会影响整个芯片的运行状态，芯片提供系统设置保护寄存器 SYSCFG_PROT。对 SYSCFG_PROT 寄存器以字方式写入 0x55AA6996 会解除写保护，对该寄存器写入其他任何值都会使能写保护。

可通过读 SYSCFG_PROT 寄存器确认写保护状态，读出值为 0x1，表示当前处于写保护状态；读出值为 0x0 表示当前处于写保护解除状态。

SYSCFG_PROT 保护的寄存器为除 SYSCFG_PROT 寄存器外的 SYSCFG、PMU、CMU、RMU 模块所有寄存器。

1.3.2 RTC 写保护

对 RTC_WPR 寄存器以字方式写入 0x55AAAA55 会解除写保护，写入其他值使能写保护。

可通过读 RTC_WPR 寄存器确认 RTC 模块是否处于写保护状态，读出值为 0x1，表示当前处于写保护状态；读出值为 0x0 表示 RTC 模块处于写保护解除状态。

该寄存器保护除自身外的 RTC 所有寄存器。

1.3.3 IWDT 写保护

对 IWDT_LOCK 寄存器以字方式写入 0x1ACCE551 会解除写保护，写入其他值使能写保护。

可通过读 IWDT_LOCK 寄存器确认 IWDT 模块是否处于写保护状态，读出值为 0x1，表示当前处于写保护状态；读出值为 0x0 表示 IWDT 模块处于写保护解除状态。该寄存器保护除自身外的 IWDT 所有寄存器。

1.3.4 WWDT 写保护

对 WWDT_LOCK 寄存器以字方式写入 0x1ACCE551 会解除写保护，写入其他值使能写保护。

可通过读 WWDT_LOCK 寄存器确认 WWDT 模块是否处于写保护状态，读出值为 0x1，表示当前处于写保护状态；读出值为 0x0 表示 WWDT 模块处于写保护解除状态。

该寄存器保护除自身外的 WWDT 所有寄存器。

1.4 写 1 清零寄存器

中断标志寄存器都是用“写 1 清零”的方式来操作。对于“写 1 清零”的寄存器，不可使用“读-修改-写”的方式来进行“写 1 清零”，否则会引起标志误清，进而产生漏中断的后果。对该类寄存器操作需要以字方式进行写。

1.5 位带操作

位带扩展区把每个 bit 扩展为一个 32-bits 的字，通过访问这些字可达到访问原始 bit 的目的；某个 bit 所在字的地址为 A，位序号为 N($0 \leq N \leq 31$)，则该 bit 位带扩展后的地址为：

SRAM: $\text{AliasAddr} = 0x22000000 + (A - 0x20000000) \times 32 + N \times 4$

外设: $\text{AliasAddr} = 0x42000000 + (A - 0x40000000) \times 32 + N \times 4$

库函数中提供位带操作 API:

RAM 位带: `void BITBAND_SRAM(uint32_t *addr, uint32_t bit, uint32_t val);`

外设位带: `void BITBAND_PER(volatile uint32_t *addr, uint32_t bit, uint32_t val);`

第2章 系统控制

2.1 系统时钟

系统上电默认使用内部 4MHz 高速时钟(HRC)作为系统时钟。

可以使用 API 获取系统时钟: `system_clock = ald_cmu_get_sys_clock()`;

2.1.1 内部高速 4MHz(默认时钟)

此种系统时钟不需要用户做任何配置。

2.1.2 外部时钟 HOSC(4~16MHz)

外部高速时钟要求为 4MHz 的倍数, 如: 4MHz、8MHz、12MHz、16MHz。

首先要确认焊接了外部高速时钟, 并已知外部高速时钟的频率, 假如外部高速时钟为 12MHz, 则配置方式如下:

```
ald_cmu_clock_config(CMU_CLOCK_HOSC, 12000000);
```

使用外部时钟时, 芯片进行软件 CHIP 复位或看门狗复位重启时, 程序正常运行前需要增加一定的延时, 确保外部晶振能正常起振。

2.1.3 72MHz

使用 HRC 倍频, 配置方式如下:

```
ald_cmu_pll_config(ALD_CMU_PLL_INPUT_HRC, ALD_CMU_PLL_OUTPUT_72M);
```

```
ald_cmu_clock_config(ALD_CMU_CLOCK_PLL, 72000000);
```

使用 HOSC 倍频, 外部高速时钟要求为 4MHz 的倍数, 如: 4MHz、8MHz、12MHz、16MHz。

首先要确认焊接了外部高速时钟, 并已知外部高速时钟的频率, 假如外部高速时钟为 12MHz, 则配置方式如下:

```
ald_cmu_pll_config(ALD_CMU_PLL_INPUT_HOSC_3, ALD_CMU_PLL_OUTPUT_72M);
```

```
ald_cmu_clock_config(ALD_CMU_CLOCK_PLL, 72000000);
```

注意事项 1: 系统时钟配置为 72Mhz 时, MSC_MEMWAIT.SRAM_W 至少需要设置为 1。

注意事项 2: 系统时钟配置为 72Mhz 时, FLASH 的等待时间至少需要设置为 3, 即 MSC.MEMWAIT.FLASH_W 在系统时钟为 72Mhz 时不能小于 3。对 MSC.MEMWAIT.FLASH_W 的设置需要放在 main 函数的第一行。

注意事项 3: SDK 系统时钟初始化后, 各总线默认分频时钟:

系统时钟	HCLK1	HCLK2	PCLK1	PCLK2
72Mhz	-	-	-	1/2
64Mhz	-	-	-	1/2
56Mhz	-	-	-	1/2
48Mhz	-	-	-	1/2

表 2-1 系统各总线默认分频

注 1: 使用 ALD 库函数时, 库函数已对上述各总线时钟进行相应分频;

注 2: 若没有特殊需求, 建议外部高速晶振使用 12MHz。

2.1.4 外部低速时钟(LOSC)

首先要确认焊接了外部低速时钟及匹配电容, 配置方式如下:

```
ald_cmu_clock_config(ALD_CMU_CLOCK_LOSC, 32768);
```

当系统时钟配置为低速时钟时(低于 1MHz), SysTick 中断将会被迫关闭, ALD 提供的延迟类函

数禁止使用。

2.2 外部晶振

外部高速振荡器的典型应用连接：

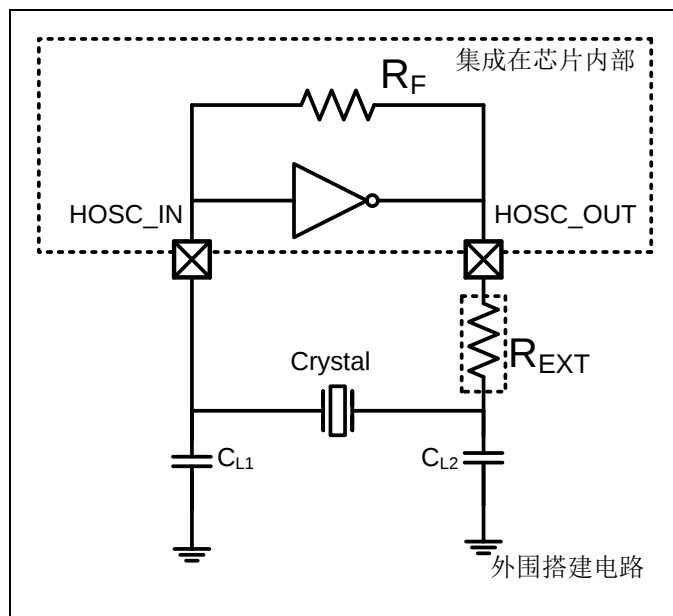


图 2-1 外部高速振荡器连接图

注 1: R_{EXT} 阻值取决于晶振规格特性；

2.3 IAP 操作程序

芯片内置 IAP 自编程固化模块，由硬件电路实现。推荐使用 IAP 方式对 FLASH 进行擦、写操作，可以减少用户代码量。

注意事项 1: 使用如下 `ald_iap_program_words()` 函数对 flash 编程，`data` 指向 FLASH 地址时，`len` 长度只能为 4，即一次只能写一个 word。

```
uint32_t ald_iap_program_words(uint32_t addr, uint8_t *data, uint32_t len,
uint32_t erase);
```

2.4 FLASH 模块

注意事项 1: 读保护规则描述：当 FLASH 的读保护级别设置为 level1 或 level2 时，运行在 SRAM 上的程序不能有读 FLASH 操作。

典型应用 A: 程序运行在 SRAM 上，响应中断请求。将中断向量表拷贝至 SRAM 中，并设置中断向量偏移地址（内核寄存器 SCB->VTOR，地址为 0xE000ED08）。

注意事项 2: MSC_MEMWAIT 寄存器的 FLASH_W 位配置访问 Flash 时的等待系统时钟数。常用系统时钟访问 Flash 时的等待时钟数如下表所示：

系统时钟	72MHz	64 MHz	56 MHz	48MHz	4Mhz
FLASH_W	≥ 3	≥ 2	≥ 2	≥ 1	无需等待

表 2-2 常用系统时钟访问 Flash 等待时钟数

注意事项 3: 在进行 FLASH 编程时，无论是否编写相同的数据，在 FLASH 编程前必须先进行擦除。

注意事项 4: FLASH 不支持同时写和读操作。如芯片在 debug 状态时，IAP 方式对 FLASH 写过程中，IDE 的 WATCH 窗口不断刷新数据（读 FLASH），可能造成 debug 状态异常，无法调试。

2.5 配置字

注意事项 1: 使用 ESBurner 擦除芯片后，需要执行配置字编程，否则将导致芯片运行不正常。即点击“擦除”按钮后，需要点击“配编”按钮。

注意事项 2: 系统配置字默认使能硬件独立看门狗。如下图所示：

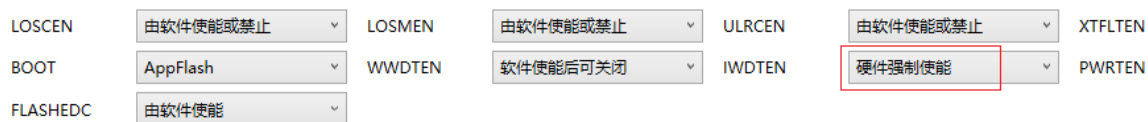


图 2-2 配置字默认使能 IWDT

第3章 外设

3.1 GPIO 模块

注意事项 1: 未使用的 IO 管脚建议设置为输出固定电平并悬空，若设置为输入，须加上拉或下拉电阻接到电源或地。

注意事项 2: 使能 GPIO 的 EXTI 中断时，外部 10ns 以内的脉冲可能会触发中断，且中断标志无法清除。规避方式参考 `ald_gpio_exti_clear_flag_status()` 接口函数。

3.2 CAN 模块

注意事项 1: 当 MCU 使用中断方式接收，通信速率是 1Mbps/s，并且帧间隔小于 30μs 时，则 MCU 的主频应不小于 48MHz，否则会有丢帧风险。

注意事项 2: 通信速率范围 10Kbits/s--1Mbps/s。当速率低于 20Kbits/s 时，要求 PCLK1 频率不超过 24MHz。

注意事项 3: 由于 CAN 标准中要求时钟精度在 1.58% 以内，故当产品的使用环境比较恶劣时，建议使用外部高精度晶振。外部晶振推荐使用 12MHz(和 ES-PDS 板保持一致)。

3.3 IIC 模块

注意事项 1: IIC 作从机时，只支持一个从机对一个主机。不支持 IIC 总线有多从机应用。

注意事项 2: IIC 的 STAT 寄存器读后，RXUD[8]、RXOV[7]、TXUD[3]、TXOV[2] 位会自动复位。

3.4 UART 模块

注意事项 1: 读 STAT 寄存器后，TFOERR[18]、RFUERR[13]、RFOERR[12] 位会自动复位。

注意事项 2: RIF 寄存器中与 FIFO 相关标志位的置位及复位条件：

标志[位]	置位条件	复位条件
TFEMPTY[16]	发送 FIFO 空	发送 FIFO 非空
TFTH[15]	发送 FIFO 小于或等于阈值	发送 FIFO 大于阈值
RFFULL[11]	接收 FIFO 满	接收 FIFO 不满
RFNEMPTY[10]	接收 FIFO 非空	接收 FIFO 空
RFTH[9]	接收 FIFO 大于等于阈值	接收 FIFO 小于阈值

表 3-1 UART FIFO 标志位置位和复位

3.5 TIMER 模块

注意事项 1: 使用外部时钟源（ET 引脚）时，中心计数模式时，计数无法触发更新事件。

3.6 SPI 模块

注意事项 1: SPI 作主机，使用 DMA 发送时，不支持 CRC 校验。

注意事项 2: 仅 SPI0 支持四线模式。使用四线模式时，SPI0 的最大时钟为 $f_{PCLK1}/4$ 。

注意事项 3: SPI 的 STAT 寄存器读后，RXUD[11]、RXOV[10]、TXUD[3]、TXOV[2] 位会自动复位。在 IDE 调试开启监测 SPI 寄存器时，标志位寄存器因 IDE 先读复位，造成程序中读标志位错误情况，此时建议先关闭 IDE 监测寄存器状态，程序先读取后再打开 IDE 监测寄存器状态。

注意事项 4: 系统时钟 72Mhz 时，SPI 作主/从机，I/O 配置为强驱，发送和接收的最大速率如下表

所示:

外设	模式		作主机		作从机	
			发送	接收	发送	接收
SPI	CPOL = 1	CPHA = 1	$f_{PCLK1}/2$	$f_{PCLK1}/2$	$f_{PCLK1}/4$	$f_{PCLK1}/4$
	其它模式		$f_{PCLK1}/4$	$f_{PCLK1}/4$	$f_{PCLK1}/4$	$f_{PCLK1}/4$

表 3-2 SPI 作主/从机时的最快速率

支持 SPI 功能 I/O 的通信最大速率如下表所示:

外设	I/O	FUNC	是否 A/D 复用	最快速率
SPI0	PA4/PA5/PA6/PA7	ALT6	是	$f_{PCLK1}/4$
	PA15/PC10/PC11/PC12	ALT4	否	$f_{PCLK1}/2$
	PA15/PB3/PB4/PB5	ALT4	否	$f_{PCLK1}/2$
SPI1	PC0/PC1/PC2/PC3	ALT4	是	$f_{PCLK1}/4$
	PC4/PC5/PB0/PB1	ALT5	是	$f_{PCLK1}/4$
	PB12/PB13/PB14/PB15	ALT4	否	$f_{PCLK1}/2$
	PA15/PB3/PB4/PB5	ALT3	否	$f_{PCLK1}/2$

表 3-3 SPI I/O 最大速率

注意事项 5: RIF 寄存器中与 FIFO 相关标志位的置位及复位条件:

标志[位]	置位条件	复位条件
RXTHRI[12]	接收 FIFO 超过阈值	FIFO 数据低于阈值
RXFR[9]	接收 FIFO 满	FIFO 不满
RXNE[8]	接收 FIFO 非空	接收 FIFO 空
TXTHRI[4]	发送 FIFO 低于阈值	发送 FIFO 大于或等于阈值
TXER[0]	发送 FIFO 空	发送 FIFO 非空后

表 3-4 SPI FIFO 标志位置位和复位

注意事项 6: 系统时钟 72Mhz, SPI 通信时钟为 $f_{PCLK1}/2$, SPI 数据长度配置为 8 位, 且使用 DMA 时, 需将对应通道 DMA_CHxCON 寄存器的 single 位复位。可参考 SDK 中 DMA 的 04_perh_to_perh_dma_flash 例程。

注意事项 7: 系统时钟 72Mhz, SPI 配置为单工模式, 且使用 DMA 时, 需将对应通道 DMA_CHxCON 寄存器的 single 位复位, SPI 通信时钟不能高于 $f_{PCLK1}/4$ 。可参考 SDK 中 DMA 的 05_perh_to_perh_dma_spi_rxo 例程。

注意事项 8: 系统时钟 72Mhz, SPI 通信时钟配置为 $f_{PCLK1}/2$ 时, PCB 上的 SCLK/MOSI/MISO 引脚走线要尽可能的短。

注意事项 9: SPI 配置中, CPOL=1 时, 对 SPI 失能再使能时, SCLK 上会产生一个系统时钟的低电平脉冲。规避方案: 在失能 SPI 后, 可先将 SCLK 引脚 MODE 切换为 0, FUNC 功能切换为 0, 失能 SPI 后再将 FUNC 切换为 SCLK 功能。

3.7 ADC 模块

注意事项 1: 系统使用 ALD 库时, 调用 ald_adc_normal_get_value()函数获取 normal 通道的采集

值；调用 `ald_adc_insert_get_value()` 函数获取 insert 通道的采集值。常温下， $f_{\text{SYS}} = 72\text{MHz}$ ， $V_{\text{REF}} = V_{\text{DD}} = 5\text{V}$ ， $f_{\text{ADC}} = 36\text{MHz}$ ， $f_s = 2\text{MHz}$ 时，DNL/INL 及采样速率如下表：

参数项	DNL	INL	UNIT
典型值	2	7	LSB
采样速率	2		MHz

表 3-5 ADC 参数

注意事项 2：对 ADC 通道 1 ~ 16 采集时，软件可修调采集值以提高 ADC 采集数据的精度。修调过程：ADC 外设初始化时，调用 `ald_get_adc_gain_offset()` 函数获取 gain 和 offset 两个参数。ADC 采集完成后，将采集的原始值、gain、offset 值带入 `ald_adc_value_adjust()` 函数进行修调。参考如下示意程序。

```
uint16_t adc_val = 0;
int32_t gain = 0;
int32_t offset = 0;
int main(void)
{
    // (1) ADC 初始化
    ald_adc_init(&h_adc);

    // (2) 根据参考源，获取修调 GAIN/OFFSET
    ald_get_adc_gain_offset(ALD_ADC_POS_REF_VDD, &gain, &offset);

    while(1)
    {
        // (3) 触发 ADC 并读取采集值
        ald_adc_normal_start(&h_adc);
        adc_val = ald_adc_normal_get_value(&h_adc);

        // (4) 对(3)中采集的 adc_val 值修调
        ald_adc_value_adjust(gain, offset, &adc_val, 1);
    }
}
```

对 ADC 采集值软件修调是用时间换精度的过程，有效采样速率受到了软件修调时间的限制。如表 3-5 所示，常温下， $f_{\text{SYS}} = 72\text{MHz}$ ， $V_{\text{REF}} = V_{\text{DD}} = 5\text{V}$ ， $f_{\text{ADC}} = 36\text{MHz}$ ， $f_s = 2\text{MHz}$ 时，经过修调后 INL/DNL 及有效采样速率：

参数项	DNL	INL	UNIT
典型值	2	3	LSB
有效采样速率	200		KHz

表 3-6 ADC 值修调参数

注意事项 3：为保证 ADC 转换结果的稳定可靠、避免噪声干扰，建议在模拟输入通道对地挂接

100nF 电容进行滤波。

3.8 内部温感

注意事项 1: ADC 通道 17 的采集值可转换为芯片当前温度。将通道 17 的 ADC 采集值带入 `ald_adc_tsensor_get_temperature()` 函数，返回值为芯片内部温度。

注意事项 2: ADC 通道 17 的采样速率 f_s 配置要小于 500K。

第4章 最小系统电路

4.1 ES32F362x LQFP64 封装芯片最小系统电路

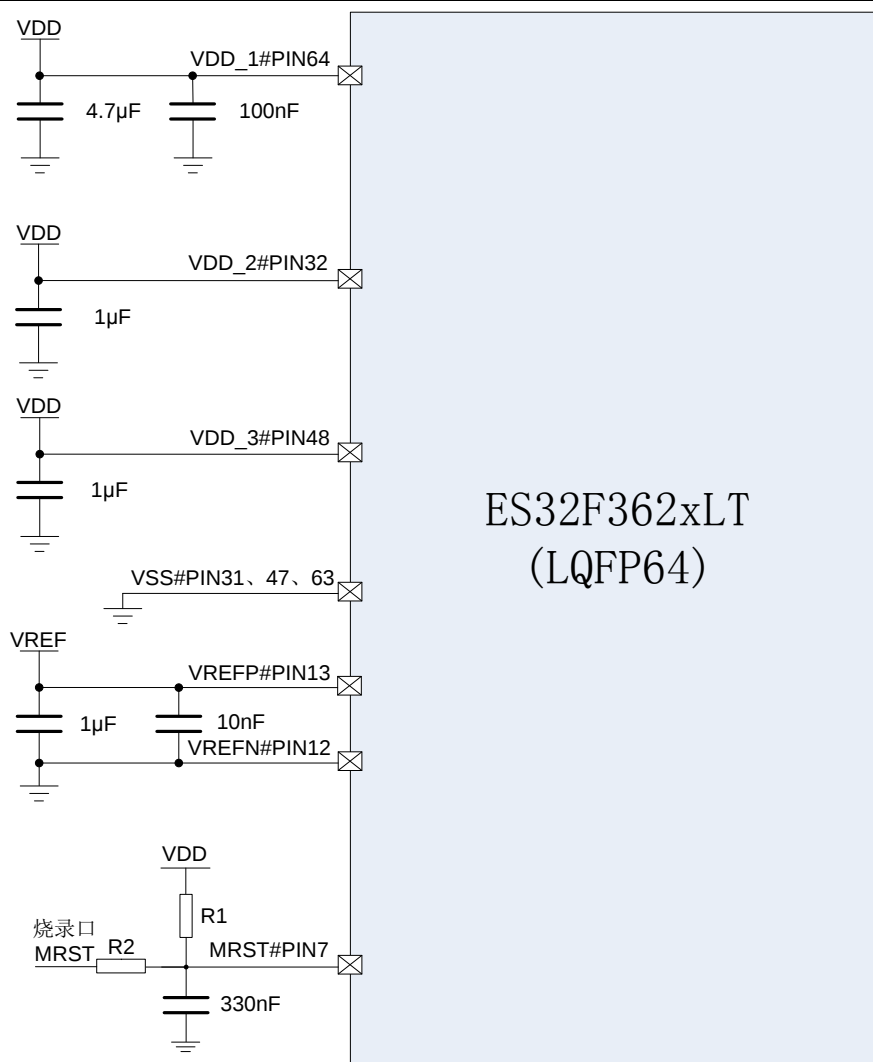


图 4-2 ES32F362x LQFP64 封装芯片最小系统电路

注 1: 每一组电源必须连接如图所示的陶瓷耦合电容。这些电容必须尽可能地靠近芯片的相应管脚, 才能保证芯片的运行性能。

注 2: MRST 引脚采用 RC 复位, 其中 $47\text{K}\Omega \leq R1 \leq 100\text{K}\Omega$, 电容 $330\text{nF} \leq C1 \leq 1\mu\text{F}$, $R2$ 为限流电阻, $0.1\text{K}\Omega \leq R2 \leq 1\text{K}\Omega$

4.2 ES32F362x LQFP48 封装芯片最小系统电路

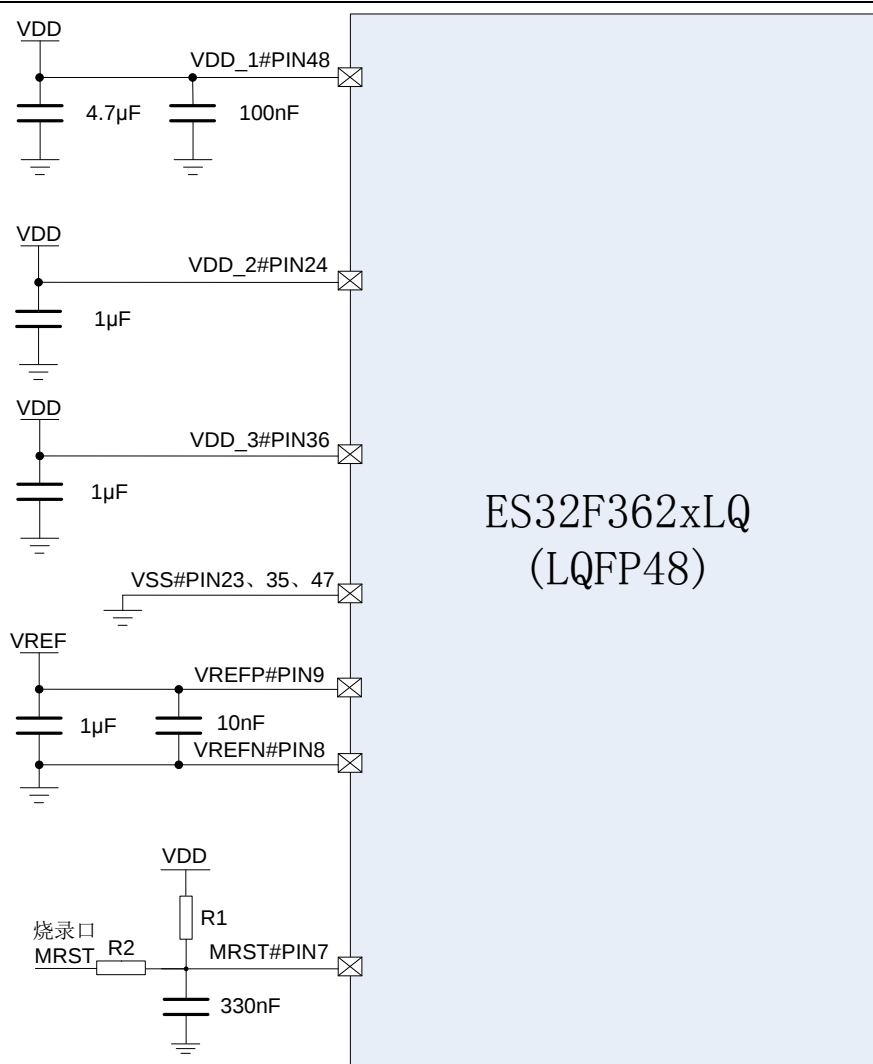


图 4-4 ES32F362x LQFP48 封装芯片最小系统电路

注 1: 每一组电源必须连接如图所示的陶瓷耦合电容。这些电容必须尽可能地靠近芯片的相应管脚, 才能保证芯片的运行性能。

注 2: MRST 引脚采用 RC 复位, 其中 $47\text{K}\Omega \leq R1 \leq 100\text{K}\Omega$, $330\text{nF} \leq C1 \leq 1\mu\text{F}$, $R2$ 为限流电阻, $0.1\text{K}\Omega \leq R2 \leq 1\text{K}\Omega$ 。